NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **ASI BLV33** is a Common Emitter Device Designed for Class A Television Applications.

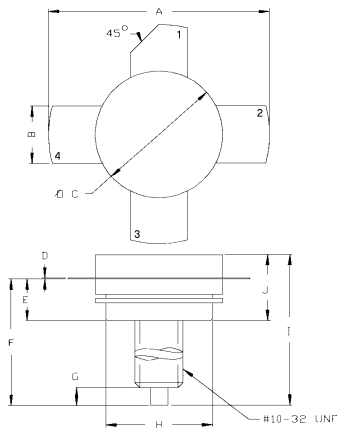
FEATURES INCLUDE:

- Gold Metalization
- Emitter Ballasting

MAXIMUM RATINGS

I_C	12.5 A
V_{CESM}	65 V
V_{CEO}	33 V
P_{DISS}	132 W @ T_C = 25 °C
T_J	-65 °C to +200 °C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	1.5 °C/W

PACKAGE STYLE .500 4L STUD



1 = COLLECTOR 2 & 4 = EMITTER
3 = BASE

	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	1.010/25,65	1.050/26,67
B	220/5,59	.230/5,84
C	495/12,57	.505/12,83
D	.003/0,08	.007/0,18
E	.160/4,06	180/4,57
F	622/15,80	
G	.100/2,54	.130/3,31
H	415/10,54	.425/10,80
I	.720/18,29	
J	250/6,35	.290/7,37

ORDER CODE: ASI10498

CHARACTERISTICS T_C = 25°C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	I_C = 100 mA	33			V
BV_{CES}	I_C = 25 mA	65			V
BV_{EBO}	I_E = 10 mA	4.0			V
I_{CES}	V_{CE} = 30 V			10	mA
h_{FE}	V_{CE} = 25 V I_C = 3.0 A	15		100	---
C_c	V_{CB} = 25 V f = 1.0 MHz		155		pF
C_{re}	V_{CE} = 25 V I_C = 100 mA f = 1.0 MHz		88		pF
C_{cs}	V_{CE} = 25 V I_C = 100 mA f = 1.0 MHz		3.0		pF
f_T	V_{CB} = 25 V I_E = 3.0 A		680		MHz
f_T	V_{CB} = 25 V I_E = 6.0 A		750		MHz
G_P	V_{CE} = 25 V I_C = 3.2 A P_{out} = 19 W f = 224.25 MHz	9.0	9.7		---

Specifications are subject to change without notice.

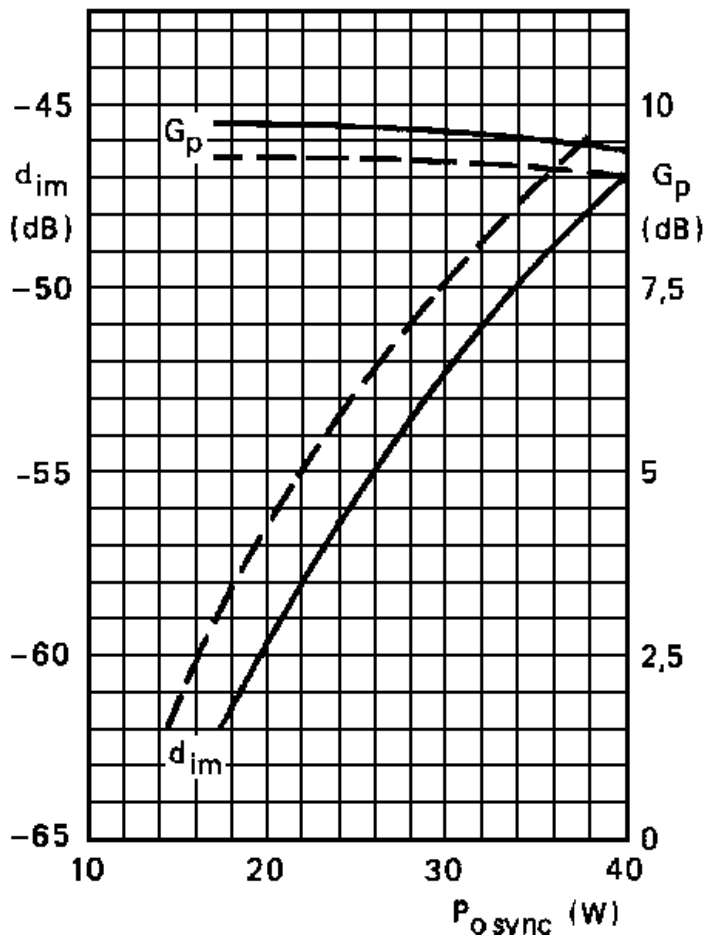


Fig. 1 Intermodulation distortion (d_{im}) and power gain as a function of output power.

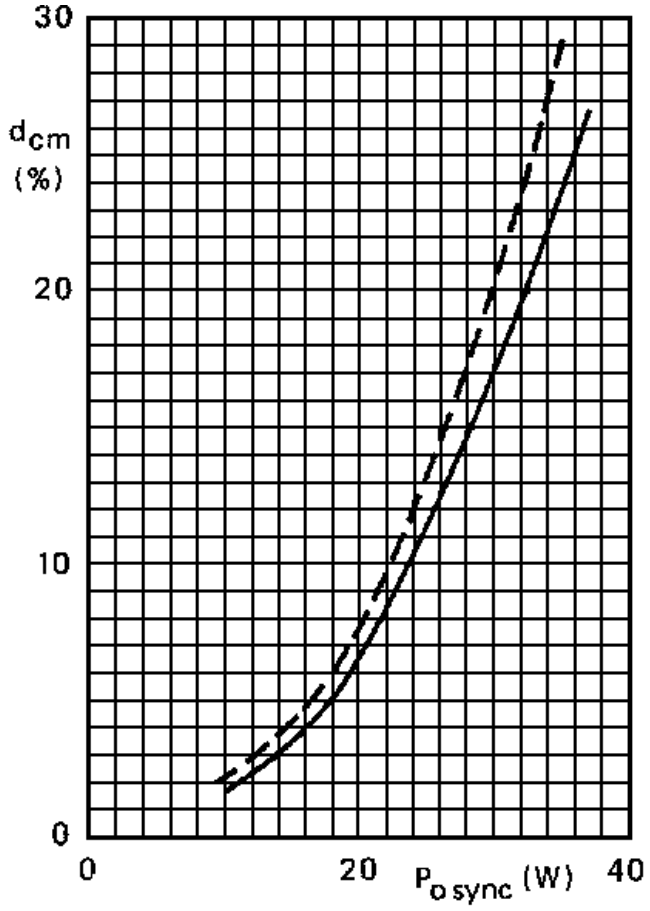


Fig. 2 Cross-modulation distortion (d_{cm}) as a function of output power.

Conditions for fig. 1 and 2:
Typical values; V_{CE} = 25 V; I_C = 3.2 A; T_h = 25°C – T_h = 70°C; f_{vision} = 224.25 MHz.

Specifications are subject to change without notice.

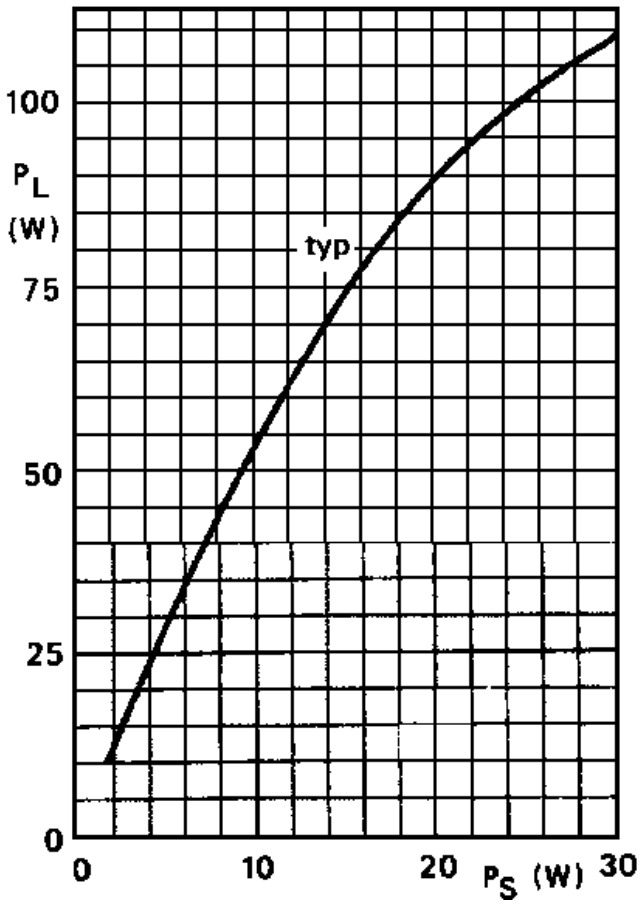


Fig. 3 V_{CE} = 28 V; $I_{C(ZS)}$ = 100 mA; T_h = 70 °C; f_{vision} = 224.25 MHz.

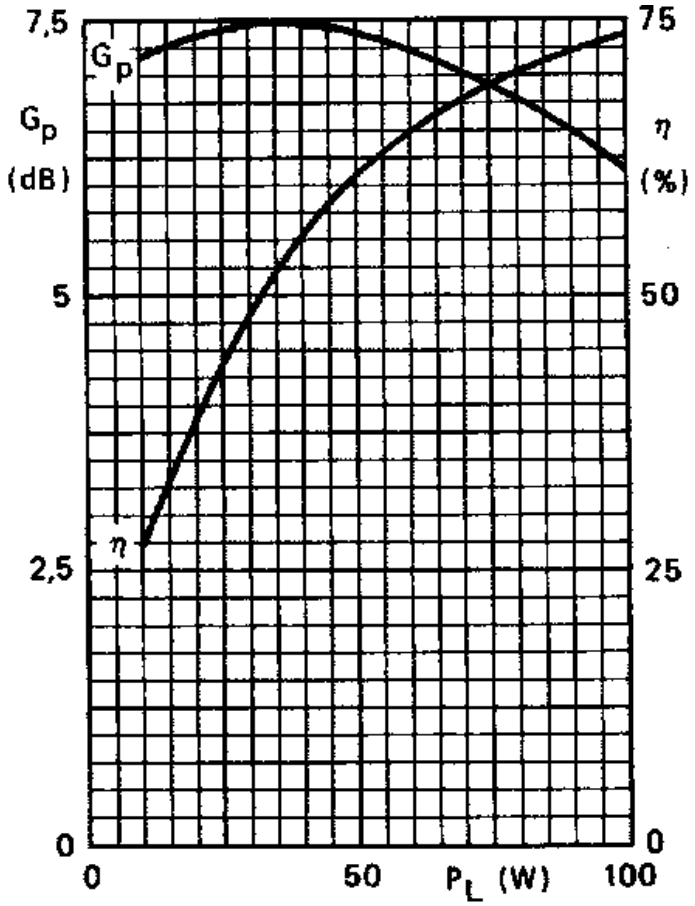


Fig. 4 V_{CE} = 28 V; $I_{C(ZS)}$ = 100 mA; T_h = 70 °C; f_{vision} = 224.25 MHz; typical values.

Specifications are subject to change without notice.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9